



2011 年 7 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝
東京都港区芝浦 1 - 1 - 1
代表者名 代表執行役社長 佐々木 則夫
(コード番号: 6502 東、大、名)
問合せ先 広 報 室 長 長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

韓国ハイニックス社とのMRAM技術の共同開発について

本日、当社は、韓国ハイニックス社とのMRAM技術の共同開発について添付のとおり発表しましたので、お知らせいたします。

以 上

2011-7-13

株式会社 東芝

韓国ハイニックス社とのMRAM技術の共同開発について

当社は、本日、韓国ハイニックス社と、MRAM (Magnetoresistive Random Access Memory : 磁気抵抗変化型ランダムアクセスメモリ) 技術を共同開発することに合意しました。今回の合意に基づき、韓国・利川 (イチョン) にあるハイニックス社の研究施設に両社の技術者を集結し、共同開発を行う計画です。

当社は半導体事業の柱として、NAND型フラッシュメモリ事業に注力しています。NAND型フラッシュメモリは、スマートフォンやタブレット、SSDといったアプリケーションの広がりにより、チップ単体のビジネスではなく、NAND型フラッシュメモリとRAMなどを組み合わせたメモリシステムとしてのビジネスが拡大してきています。

MRAMは、低消費電力で、書き込み速度が高速という特長を持つ不揮発性メモリです。NAND型フラッシュメモリとMRAMを組み合わせたシステムにより、今後、NAND型フラッシュメモリの新たなアプリケーションの創出が期待できます。そのような中、当社は、これまで積極的にMRAMの研究開発に取り組んできており、2007年には、当社独自の垂直磁化方式の記憶素子を開発するなど、MRAMの研究開発で業界をリードしてきました。

今回、MRAM開発に実績のあるハイニックス社との共同開発により、開発コストの負担を抑制しつつ、MRAMの実用化に向けた取り組みを加速するとともに、MRAMの早期実用化によりメモリシステムビジネスを推進していきます。

また、ハイニックス社とは今後の開発動向を確認しながら、将来的な製造での協業についても、今後協議していく予定です。

当社は、7月に実施した組織改編に加え、今回の協業をひとつのステップとして、NAND、HDDを含めたストレージ事業におけるメモリ統合ソリューションの推進を主導していきます。

以 上

本資料に関するお問い合わせ先：

広報室 広報担当 櫻井、加来

TEL 03 (3457) 2100